

## 授賞式

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 日にち：9/18(火)   | 会場：224A                |
| 11:00 - 11:10 | Exhibition Award 表彰式   |
| 11:10 - 11:40 | 第44回「講演奨励賞」贈呈式         |
| 15:45 - 16:30 | 代議員会議                  |
| 16:30 - 18:45 | 功労会員表彰式、論文賞表彰式、フェロー表彰式 |

## 第40回応用物理学会論文賞 受賞記念講演

| 優秀論文賞受賞記念講演 |               |      |                                                                                                                             |                                       |
|-------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 9/18(火)     | 13:30 - 14:00 | 222  | Development of plasma-on-chip: Plasma treatment for individual cells cultured in media                                      | 熊谷 慎也<br>(名城大)                        |
| 9/18(火)     | 14:45 - 15:15 | 212A | Room-temperature direct band-gap electroluminescence from germanium (111)-fin light-emitting diodes                         | 谷 和樹<br>(PETRA,PECST,日立)              |
| 9/19(水)     | 09:00 - 09:30 | 233  | Reexamination of Fermi level pinning for controlling Schottky barrier height at metal/Ge interface                          | 西村 知紀<br>(東大)                         |
| 9/19(水)     | 13:00 - 13:30 | 224A | Delta-doped $\beta$ -gallium oxide field-effect transistor                                                                  | Siddharth Rajan<br>(Ohio State Univ.) |
| 9/19(水)     | 15:00 - 15:30 | CE   | Hydride-vapor-phase epitaxial growth of highly pure GaN layers with smooth as-grown surfaces on freestanding GaN substrates | 藤倉 序章<br>(サイオクス)                      |
| 9/21(金)     | 13:00 - 13:30 | 131  | Room-temperature spin transport in n-Ge probed by four-terminal nonlocal measurements                                       | 山田 道洋<br>(阪大)                         |

| 論文奨励賞受賞記念講演 |               |      |                                                                                                                                      |                 |
|-------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9/20(木)     | 15:15 - 15:30 | 224B | Effect of organic moieties on the scintillation properties of organic-inorganic layered perovskite-type compounds                    | 河野 直樹<br>(秋田大)  |
| 9/21(金)     | 09:45 - 10:00 | 144  | Roles of charged particles and reactive species on cell membrane permeabilization induced by atmospheric-pressure plasma irradiation | 佐々木 渉太<br>(東北大) |

| 解説論文賞受賞記念講演 |               |     |                                                                                                                                         |               |
|-------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9/19(水)     | 09:30 - 10:00 | 143 | High resolution characterizations of fine structure of semiconductor device and material using scanning nonlinear dielectric microscopy | 長 康雄<br>(東北大) |
| 9/20(木)     | 15:30 - 16:00 | 131 | 固体量子情報デバイスの現状と将来展望 万能デジタル量子コンピュータの実現に向けて                                                                                                | 伊藤 公平<br>(慶大) |

## 分科会 受賞記念講演

| 放射線奨励賞受賞記念講演 |               |      |                                    |                  |
|--------------|---------------|------|------------------------------------|------------------|
| 9/20(木)      | 13:30 - 13:45 | 224B | 大きな実効原子番号と高い発光量を有するハロゲン化物シンチレータの研究 | 藤本 裕<br>(東北大)    |
| 9/20(木)      | 13:45 - 14:00 | 224B | 新規フッ化物中性子シンチレータの開発                 | 河口 範明<br>(奈良先端大) |

| プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演 |               |     |                                                    |                |
|---------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------|----------------|
| 9/19(水)             | 10:45 - 11:15 | 141 | 極端紫外および軟X線光源用多価電離プラズマの協同的トムソン散乱計測 - 点光源を空間分解計測する - | 富田 健太郎<br>(九大) |
| 9/19(水)             | 11:15 - 11:45 | 141 | 水素原子バルマー $\alpha$ 線のシュタルク分光計測によるシース領域における電界計測法     | 西山 修輔<br>(北大)  |

| 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞受賞記念講演 |               |     |                                       |                |
|------------------------------|---------------|-----|---------------------------------------|----------------|
| 9/19(水)                      | 13:30 - 14:00 | 222 | 一分子計測による基板支持人工脂質二重膜の膜物性評価と膜タンパク質系への応用 | 茂木 俊憲<br>(群馬大) |

# 国際フェロー 受賞記念講演

## 第11回（2017年度）国際フェロー 受賞記念講演

|         |               |      |                                                                    |                                         |
|---------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9/18(火) | 13:15 - 14:00 | 211B | Strong Light-Matter Interactions in a Material Science Perspective | Thomas Ebbesen<br>(Univ. of Strasbourg) |
|---------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## 第12回（2018年度）国際フェロー 受賞記念講演

|         |               |      |                                   |                                                            |
|---------|---------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 9/18(火) | 14:00 - 14:45 | 211B | Meta-lens for imaging and sensing | Din Ping Tsai<br>(Academia Sinica, and Nat'l Taiwan Univ.) |
|---------|---------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|

# 第43回（2017年春季）応用物理学会講演奨励賞 受賞記念講演

## 講演奨励賞とは？

講演奨励賞とは、講演奨励賞とは優秀な一般講演論文を発表した若手会員に与えられる賞です。受賞者は次に行われる講演会で記念講演を行うことができます。一般投稿件数の1%を目安に与えられる名誉ある賞です。

| 開催日         | 時間            | 会場   | 中分類分科名・講演タイトル・所属・著者                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9/18<br>(火) | 13:15 - 13:30 | 231A | 1.5 計測技術・計測標準<br>超低位相雑音マイクロ波発生と、光サンプリング法による高感度位相雑音測定法<br>○遠藤 護 <sup>1</sup> , Tyko Shoji D. <sup>1</sup> , Schibli Thomas R. <sup>1,2,3</sup> (1.コロラド大、2.NIST、3.JILA)                                                                                                                                                        |  |
|             | 13:45 - 14:00 | 136  | 3.7 レーザープロセッシング<br>レーザーアプレーション閾値のフルエンス・パルス幅依存性精密測定<br>○高橋 孝 <sup>1,2</sup> , 谷 峻太郎 <sup>1</sup> , 黒田 隆之助 <sup>2</sup> , 坂上 和之 <sup>3</sup> , 鷲尾 方一 <sup>3</sup> , 小林 洋平 <sup>1,2</sup> (1.東大物性研、2.産総研オベラントOIL、3.早大理工研)                                                                                                       |  |
|             | 09:30 - 09:45 | 438  | 3.10 量子物理・技術<br>二つのドメインから成るスピン系における負温度スピン状態への緩和現象と量子エンタングルメント<br>○濱 祐介 <sup>1</sup> , 湯川 英美 <sup>2</sup> , ウィリアム マンロー <sup>3,4</sup> , 根本 香絵 <sup>1</sup> (1.国立情報学研究所、2.理化学研究所、3.NTT物性科学研究所)                                                                                                                                 |  |
|             | 13:15 - 13:30 | 212A | 3.15 シリコンフォトニクス<br>Directly modulated quantum dot lasers epitaxially grown on Si<br>○井上 大輔 <sup>1,2</sup> , Daehwan Jung <sup>2</sup> , Justin Norman <sup>2</sup> , Yating Wan <sup>2</sup> , 西山 伸彦 <sup>1</sup> , 荒井 滋久 <sup>1</sup> , Arthur C. Gossard <sup>2</sup> , John E. Bowers <sup>2</sup> (1.東工大未来研、2.ECE, UCSB) |  |
|             | 13:30 - 13:45 | 223  | 6.3 酸化物エレクトロニクス<br>酸化物ドットを担持したLiCoO <sub>2</sub> エピタキシャル薄膜の作製とその高速充放電特性のドット種依存性<br>○安原 颯 <sup>1</sup> , 吉川 祐未 <sup>2</sup> , 寺西 貴志 <sup>2</sup> , 安井 伸太郎 <sup>1</sup> , 谷山 智康 <sup>1,3</sup> , 伊藤 満 <sup>1</sup> (1.東工大、2.岡山大学、3.名古屋大学)                                                                                      |  |
|             | 14:15 - 14:30 | 431B | 6.5 表面物理・真空<br>熱伝導率制御に向けた非整合チムニラダー構造FeGe <sub>2</sub> /Siのエピタキシャル成長<br>○寺田 史 <sup>1</sup> , 石部 貴史 <sup>1</sup> , 渡辺 健太郎 <sup>2</sup> , 中村 芳明 <sup>1,3</sup> (1.阪大院基礎工、2.東北大、3.CREST-JST)                                                                                                                                     |  |
|             | 13:15 - 13:30 | 211A | 12.3 機能材料・萌芽的デバイス<br>フォトクロミックターアアリーレンを用いた分子光熱貯蓄変換材料の開発<br>○朝戸 良輔 <sup>1,2</sup> , Jan Patrick Calupitan <sup>3</sup> , 中嶋 琢也 <sup>1</sup> , Jyh-Chiang Jiang <sup>4</sup> , 河合 壯 <sup>1</sup> (1.奈良先端大、2.Toulouse Univ., 3.Paris-Saclay Univ., 4.台湾科技大)                                                                      |  |
|             | 10:30 - 10:45 | 146  | 15.4 III-V族窒化物結晶<br>ラマン分光法によるGaN単結晶における貫通転位の歪み場解析<br>○小久保 信彦 <sup>1,2</sup> , 角岡 洋介 <sup>1,2</sup> , 藤原 文博 <sup>1</sup> , 大原 淳士 <sup>1</sup> , 恩田 正一 <sup>1</sup> , 山田 永 <sup>2</sup> , 清水 三聡 <sup>2</sup> , 原田 俊太 <sup>1</sup> , 田川 美穂 <sup>1</sup> , 宇治原 徹 <sup>1,2</sup> (1.名大、2.産総研)                                     |  |
| 9/19<br>(水) | 13:15 - 13:30 | 225B | 3.11 フォトニック構造・現象<br>グラフェン装荷プラズモニック導波路による超高速全光スイッチ<br>○小野 真証 <sup>1,2</sup> , 畑 雅則 <sup>2,3</sup> , 野崎 謙悟 <sup>1,2</sup> , 角倉 久史 <sup>1,2</sup> , 納富 雅也 <sup>1,2,3</sup> (1.NTTナノフォトニクスセンタ、2.NTT物性科学基礎研、3.東工大)                                                                                                                |  |
|             | 13:45 - 14:00 | 133  | 6.1 強誘電体薄膜<br>ScAlN, ZnOおよびPZT系薄膜の極性制御と分極反転デバイスへの応用<br>○清水 貴博 <sup>1,2</sup> , 柳谷 隆彦 <sup>1,2,3</sup> (1.早大院・先進理工、2.材研、3.JSTさきがけ)                                                                                                                                                                                            |  |
|             | 13:30 - 13:45 | 234A | 7.3 微細パターン・微細構造形成技術<br>細胞伸展制御のためのポリマー表面へのフェムト秒レーザー照射によるナノ周期構造形成<br>○竹中 啓輔 <sup>1</sup> , 塚本 雅裕 <sup>2</sup> , 佐藤 雄二 <sup>2</sup> , 村井 健介 <sup>3</sup> , 浅井 知 <sup>1</sup> (1.阪大院工、2.阪大接合研、3.産総研)                                                                                                                             |  |
|             | 13:45 - 14:00 | 437  | 9.5 新機能材料・新物性<br>デュアルゲートデバイスによるトポロジカル絶縁体表面の磁気輸送特性制御<br>○三澤 哲郎 <sup>1,2</sup> , 福山 康弘 <sup>2</sup> , 中村 秀司 <sup>2</sup> , 岡崎 雄馬 <sup>2</sup> , 名坂 成昭 <sup>1</sup> , 金子 晋久 <sup>2</sup> , 浦野 千春 <sup>2</sup> , 笹川 崇男 <sup>1</sup> (1.東工大、2.産総研)                                                                                |  |
|             | 10:45 - 11:00 | 331  | 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術<br>室温動作TMRセンサを用いた脳磁図および心磁図の測定<br>○藤原 耕輔 (東北大院工)                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|             | 15:30 - 15:45 | 212B | 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用<br>バイクリスタルSmBa <sub>2</sub> Cu <sub>3</sub> O <sub>7</sub> 薄膜における低温強磁場中の粒界磁束ピンニング特性<br>○土屋 雄司 <sup>1</sup> , 秋田 純也 <sup>1</sup> , 一野 祐亮 <sup>1</sup> , 岡田 達典 <sup>2</sup> , 淡路 智 <sup>2</sup> , 吉田 隆 <sup>1</sup> (1.名大工、2.東北大金研)                                                                        |  |
|             | 09:00 - 09:15 | 211A | 12.3 機能材料・萌芽的デバイス<br>高感度印刷型圧力センサによる脈波伝搬速度の測定<br>○関根 智仁 <sup>1</sup> , 竹田 泰典 <sup>1</sup> , 松井 弘之 <sup>1</sup> , 熊木 大介 <sup>1</sup> , Fabrice Domingues Dos Santoce <sup>2</sup> , 宮保 淳 <sup>3</sup> , 時任 静士 <sup>1</sup> (1.山形大ROEL、2.Piezotech、3.アルケマ株式会社)                                                                  |  |
|             | 16:30 - 16:45 | 145  | 12.4 有機EL・トランジスタ<br>イメージング質量分析法を用いた有機EL素子の劣化反応機構の解明<br>○重松 沙樹 <sup>1</sup> , 宮里 朗夫 <sup>2</sup> , 宮林 恵子 <sup>3</sup> , 酒井 平祐 <sup>1</sup> , 村田 英幸 <sup>1</sup> (1.北陸先端大 先端科学技術、2.北陸先端大 ナノセンター、3.静岡大院 総合科学技術)                                                                                                                 |  |

# 第44回（2018年春季）応用物理学会講演奨励賞 受賞記念講演

| 開催日         | 時間            | 会場   | 中分類科名・講演タイトル・所属・著者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9/19<br>(水) | 13:45 - 14:00 | 145  | 12.4 有機EL・トランジスタ<br>フレキシブル印刷有機回路の乳酸センサ応用<br>○塩飽 黎 <sup>1,2,5</sup> 、松井 弘之 <sup>1,2</sup> 、長峯 邦明 <sup>1,2</sup> 、植松 真由 <sup>1</sup> 、眞野 泰誠 <sup>1</sup> 、丸山 祐樹 <sup>1</sup> 、野村 綾子 <sup>2</sup> 、土屋 和彦 <sup>2</sup> 、早坂 和将 <sup>3</sup> 、竹田 泰典 <sup>2</sup> 、<br>福田 貴 <sup>4</sup> 、熊木 大介 <sup>2</sup> 、時任 静士 <sup>1,2</sup> (1.山形大院有材シ、2.山形大ROEL、3.山形大院理工、4.東ソー、5.学振特別研究員DC)                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 10:30 - 10:45 | 145  | 12.4 有機EL・トランジスタ<br>新奇低分子系n型有機半導体の電子輸送特性<br>○熊谷 翔平 <sup>1</sup> 、渡邊 峻一郎 <sup>1,2</sup> 、石井 宏幸 <sup>3</sup> 、福岡 英治 <sup>4</sup> 、谷 征夫 <sup>4</sup> 、杉浦 寛記 <sup>4</sup> 、渡邊 哲也 <sup>4</sup> 、佐藤 寛泰 <sup>5</sup> 、山野 昭人 <sup>5</sup> 、<br>黒澤 忠法 <sup>1</sup> 、竹谷 純一 <sup>1</sup> 、岡本 敏宏 <sup>1,2</sup> (1.東大院新領域、2.JSTさきがけ、3.筑波大数物、4.富士フイルム、5.リガク)                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 13:15 - 13:30 | 221C | 12.7 医用工学・バイオチップ<br>マイクロ波散乱場断層イメージングシステムの開発と乳癌組織の検出<br>○稲垣 明里 <sup>1</sup> 、木村 建次郎 <sup>1,5</sup> 、谷野 裕一 <sup>5,7</sup> 、三木 万由子 <sup>2,5</sup> 、高尾 信太郎 <sup>2,5,7</sup> 、渡邊 奈津子 <sup>4,5</sup> 、小西 豊 <sup>4,5</sup> 、岡本 交二 <sup>4,5</sup> 、松本 元 <sup>3,5</sup> 、山神 和彦 <sup>3,5</sup> 、<br>美馬 勇輝 <sup>5,6</sup> 、土井 恭二 <sup>5,6</sup> 、木村 憲明 <sup>5,6</sup> (1.神大院理、2.兵庫がんセンター、3.神鋼病院、4.伍仁会、5.AMED、6.IGS、7.神大病院)                                                                                                                                                                              |
|             | 13:45 - 14:00 | 436  | 13.2 探索的材料物性・基礎物性<br>BaSi <sub>2</sub> pn ホモ接合太陽電池の作製と特性評価<br>○小玉 小桃、Deng Tianguo、Xu Zhihao、山下 雄大、都甲 薫、末益 崇 (筑波大)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 09:30 - 09:45 | 233  | 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術<br>Evaluation of Contact Resistivity of Ni(Ge <sub>1-y</sub> Sn <sub>y</sub> )/Heavily Sb-doped n-Ge <sub>1-x</sub> Sn <sub>x</sub> Contact<br>○Jihee Jeon <sup>1</sup> 、Akihiro Suzuki <sup>1,2</sup> 、Kouta Takahashi <sup>1,2</sup> 、Osamu Nakatsuka <sup>1,3</sup> 、Shigeaki Zaima <sup>4</sup><br>(1.Grad. Sc. of Eng., Nagoya Univ., 2.Research Fellow of JSPS、3.IMASS, Nagoya Univ., 4.IIFS, Nagoya Univ.)                                                                                                                                           |
|             | 13:15 - 13:30 | 224B | 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料<br>カーボンナノチューブ薄膜を電極として用いた透明で伸縮性のある摩擦帯電型発電シート<br>○松永 正広 <sup>1</sup> 、廣谷 潤 <sup>2</sup> 、岸本 茂 <sup>2</sup> 、大野 雄高 <sup>2,3</sup> (1.名大VBL、2.名大工、3.名大未来研)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9/20<br>(木) | 10:15 - 10:30 | 224B | 2.1 放射線物理一般・検出器基礎<br>銀添加リン酸塩ガラスにおけるラジオフォトルミネッセンス中心形成機構<br>○川本 弘樹 <sup>1</sup> 、藤本 裕 <sup>1</sup> 、越水 正典 <sup>1</sup> 、岡田 豪 <sup>2</sup> 、柳田 健之 <sup>2</sup> 、浅井 圭介 <sup>1</sup> (1.東北大院工、2.奈良先端大)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 13:15 - 13:30 | 224A | 3.12 ナノ領域光学・近接場光学<br>金三角形プレートプラズモンの静的および動的空間特性の可視化<br>○今枝 佳祐、長谷川 誠樹、井村 考平 (早大理工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 16:45 - 17:00 | 438  | 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理<br>プラズマ誘起ダメージを受けた局所構造の第一原理計算による解析 (2)<br>○吉川 侑汰、江利口 浩二 (京大院工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 09:00 - 09:15 | 141  | 15.6 IV族系化合物 (SiC)<br>ゲート酸化膜厚および窒化処理がSiC MOS反転層移動度へ及ぼす影響<br>○野口 宗隆 <sup>1</sup> 、岩松 俊明 <sup>1</sup> 、網代 啓之 <sup>1</sup> 、渡邊 寛 <sup>1</sup> 、喜多 浩之 <sup>2</sup> 、三浦 成久 <sup>1</sup> (1.三菱電機、2.東大院工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 09:00 - 09:15 | 135  | 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス<br>ZnO薄膜の誘導放出における励起子利得機構<br>○松崎 涼介 <sup>1</sup> 、安達 裕 <sup>2</sup> 、内野 隆司 <sup>1</sup> (1.神戸大、2.物材機構)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 13:45 - 14:00 | 311  | 17.2 グラフェン<br>音響電流を活用するグラフェン表面弾性波センサの開発<br>○奥田 聡志 <sup>1</sup> 、金井 康 <sup>2</sup> 、小野 亮生 <sup>2</sup> 、嶋谷 政彰 <sup>1,3</sup> 、小川 新平 <sup>1</sup> 、生田 昂 <sup>2,3</sup> 、井上 恒一 <sup>2</sup> 、<br>前橋 兼三 <sup>2,3</sup> 、松本 和彦 <sup>2</sup> (1.三菱電機、2.阪大産研、3.東京農工大)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 13:30 - 13:45 | 234A | 21.1 合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」<br>PLD法によるβ-(Ga <sub>1-y</sub> Sc <sub>y</sub> ) <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 薄膜成長とバンドギャップ変調<br>○若林 諒 <sup>1</sup> 、吉松 公平 <sup>1</sup> 、大友 明 <sup>1,2</sup> (1.東工大物質理工学院、2.元素戦略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9/21<br>(金) | 13:15 - 13:30 | 234A | 3.4 生体・医用光学<br>繰り返し誘導遷移を用いた非線形蛍光顕微鏡による高解像イメージング<br>○嶽 文宏、福武 直樹、林 世莉、瀧 優介 (二コン研究開発本部)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 09:00 - 09:15 | 224A | 3.12 ナノ領域光学・近接場光学<br>円偏光によるプラズモニックナノ構造へのキラリティー転写<br>○齋藤 混一郎、立間 徹 (東大生研)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 11:30 - 11:45 | 144  | 8.4 プラズマライフサイエンス<br>プラズマ活性ラクトックの抗腫瘍作用物質の解明<br>○細井 祐吾、石川 健治、橋爪 博司、田中 宏昌、吉川 史隆、水野 正明、堀 勝 (名大)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 14:00 - 14:15 | 438  | 9.4 熱電変換<br>インピーダンススペクトロスコピー法に基づいた熱電変換モジュールの無次元性能指数zTの評価<br>○大塚 美緒子 <sup>1,2</sup> 、長谷川 靖洋 <sup>1</sup> (1.埼玉大学大学院、2.JSPS特別研究員DC1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 09:00 - 09:15 | 131  | 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関<br>Spin switching effect in GdN/NbN/GdN superconducting spin valves<br>○Yota Takamura <sup>1,2</sup> 、Juan Pedro Cascales <sup>1</sup> 、Rafaelo S. Goncalves <sup>1,3</sup> 、Greg M. Stephen <sup>4</sup> 、Donald Heiman <sup>4</sup> 、<br>Atilgan Altinkok <sup>1,5</sup> 、Clodoaldo I.L. de Araujo <sup>3</sup> 、Biswarup Satpati <sup>6</sup> 、Valeria Lauter <sup>7</sup> 、Jagadeesh S. Moodera <sup>1</sup><br>(1.MIT、2.Tokyo Tech、3.Federal Univ. of Vicosas、4.Northeastern Univ., 5.Giresun Univ., 6.Saha Inst. of Nuclear Phys., 7.Oak Ridge National Lab.) |
|             | 10:30 - 10:45 | 145  | 13.3 絶縁膜技術<br>ナノZrO <sub>2</sub> 核生成層を用いた強誘電体Hf <sub>x</sub> Zr <sub>1-x</sub> O <sub>2</sub> 薄膜の作製技術<br>○女屋 崇 <sup>1,2,3</sup> 、生田目 俊秀 <sup>2</sup> 、澤本 直美 <sup>1</sup> 、大井 暁彦 <sup>2</sup> 、池田 直樹 <sup>2</sup> 、長田 貴弘 <sup>2</sup> 、小椋 厚志 <sup>1</sup><br>(1.明治大学、2.物質・材料研究機構、3.学振特別研究員DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 13:15 - 13:30 | 145  | 13.3 絶縁膜技術<br>Thermal oxidation kinetics of Ge under high O <sub>2</sub> pressure<br>○Xu Wang、Tomonori Nishimura、Takeaki Yajima、Akira Toriumi(Tokyo Univ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 09:00 - 09:15 | 143  | 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス<br>近接場光を利用した光-電気-機械結合系<br>○浅野 元紀 <sup>1</sup> 、太田 竜一 <sup>1</sup> 、山本 俊 <sup>2</sup> 、岡本 創 <sup>1</sup> 、山口 浩司 <sup>1</sup> (1.NTT物性基礎研、2.阪大基礎工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 09:00 - 09:15 | 141  | 15.6 IV族系化合物 (SiC)<br>4H-SiCにおける基底面らせん転位の貫通刃状転位への変換現象に関する反応経路解析<br>○田村 陽平 <sup>1</sup> 、榊間 大輝 <sup>2</sup> 、波田野 明日可 <sup>2</sup> 、泉 聡志 <sup>2</sup> (1.富士フイルム、2.東大)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |